

SOI IC 3-8 译码器芯片

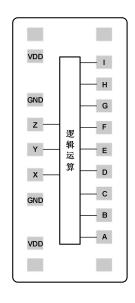
主要特点

该芯片是采用硅工艺制作的 3-8 译码器芯片。

工作电压: 5V 静态电流: 200uA 驱动电流: 2.6mA

芯片尺寸: 0.66x1.64x0.18mm

功能框图



性能指标 (T_A = +25℃, VDD = 5 V)

参数	符号	最小	典型	最大	单位	说明
工作电源电压	V_{DD}	4	5	6	V	-
电源静态电流	I_{DD}	-	200	-	uA	I _o =0
驱动电流	lo	-	2.6	-	mA	-
输出高电平电压	V_{oh}	-	5	-	V	输出开路
输出低电平电压	Vol	-	0	-	V	输出开路
输入高电平电压	Vih	3	-	5	V	
输入低电平电压	V _{ih}	0	-	0.5	V	
开关时间	t _{pd}	-	10	-	ns	

真值表

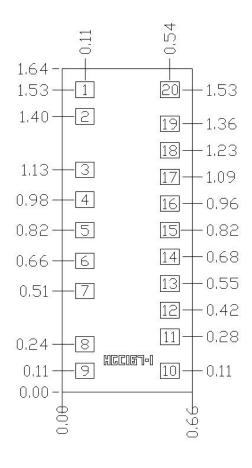
	输入		输出								
X	Y	Z	Α	В	С	D	E	F	G	Н	I
0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1
0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1
0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0
0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1
1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1
1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1

^{*} 输入 "0" 电平范围: 0~0.5V; 输入 "1" 电平范围: 3~5V。



SOI IC 3-8 译码器芯片

物理参数



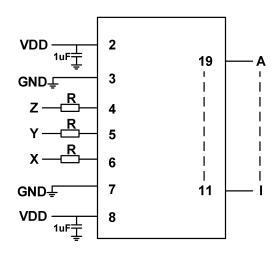
焊盘描述

焊盘序号	焊盘名称	焊盘描述		
1	直通焊盘	与 20 焊盘互连		
2,8	VDD	电源		
3,7	GND	地		
4-6	Z, Y, X	地址输入		
9-10	直通焊盘	9、10 焊盘互连		
11-19	A-I	输出		
20	直通焊盘	与1焊盘互连		



SOI IC 3-8 译码器芯片

推荐应用电路



*R=1KΩ-3KΩ, VDD、GND 焊盘任选一组使用。

注意事项

- 1. 典型键合焊盘尺寸为: 85x100um;
- 2. VDD、GND 焊盘任选一组使用;
- 3. 输入端应串联 1KΩ-3KΩ的保护电阻,在满足开 关速度的前提下,保护电阻越大越好。输入端 不能悬空。

极限参数

- 1. 电源电压: 6V
- 2. 储存温度: -65~+150 ℃
- 3. 工作温度: -55 ~ +125 ℃